Univerzitet u Banjoj Luci Elektrotehnički fakultet Katedra za elektroniku

Četvrta laboratorijska vježba

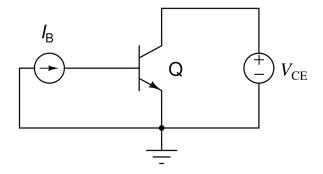
Osnovi elektronike i digitalne tehnike

Sažetak

Kroz ovu laboratorijsku vježbu, cilj je, kroz snimanje statičkih karakteristika, upoznati se sa načinom rada bipolarnih i MOS tranzistora.

1 Snimanje statičkih karakteristika bipolarnog tranzistora

Koristeći programski paket LTspice, nacrtati šemu sa slike 1. Model tranzistora Q je BC547. Potrebno je snimiti izlazne statičke karakteristike tranzistora, tj. zavisnost struje kolektora od napona kolektorsko-emiterskog spoja, za vrijednosti jačine struje baze iz skupa $\{100, 200, 300, 400, 500\}$ μ A.



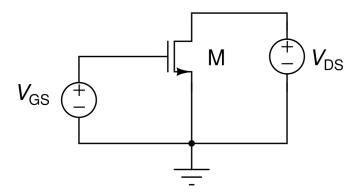
Slika 1: Kolo za snimanje statičkih karakteristika bipolarnog tranzistora

2 Snimanje statičkih karakteristika MOS tranzistora

Nacrtati kolo sa slike 2. Model tranzistora M je BSP89. Potrebno je snimiti sljedeće karakteristike:

 \bullet izlazne statičke karakteristike, tj. zavisnost struje drejna od napona drejn-sors, pri čemu napon gejt-sors uzima vrijednosti iz skupa $\{1,3,3.4,3.6\}$ V

- prenosnu karakteristiku tranzistora, tj. zavisnost struje drejna od napona gejt-sors, pri fiksiranom naponu drejn-sors. Karakteristiku snimiti za opseg vrijednosti napona gejt-sors od 0 do 4 V, a drejn-sors postaviti na 5V.
- $\bullet\,$ prenosne karakteristike za vrijednosti temperature iz skupa $\{-55,25,125\}\,^{\circ}\mathrm{C}$



Slika 2: Kolo za snimanje statičkih karakteristika MOS tranzistora